



概述

S2208SJ-LXR 是一款恒压输出的离线型电流模式 PWM 电源管理芯片，内置 $1.9\ \Omega/650\text{V}$ 的超结硅功率 MOS，拥有极小的开关损耗，S2208SJ-LXR 具有全负载高效率、低空载损耗、低 EMI 干扰和高 EMS 抗干扰、极少外围应用元件等优点。S2208SJ-LXR 在一定条件下适用于输入电压 AC90V-264V 的输出功率为 18W 以内的离线式反激开关变换器，满足 6 级能效标准。S2208SJ-LXR 采用 SOP-8 封装，且采用单边漏极带散热片增加散热效果。

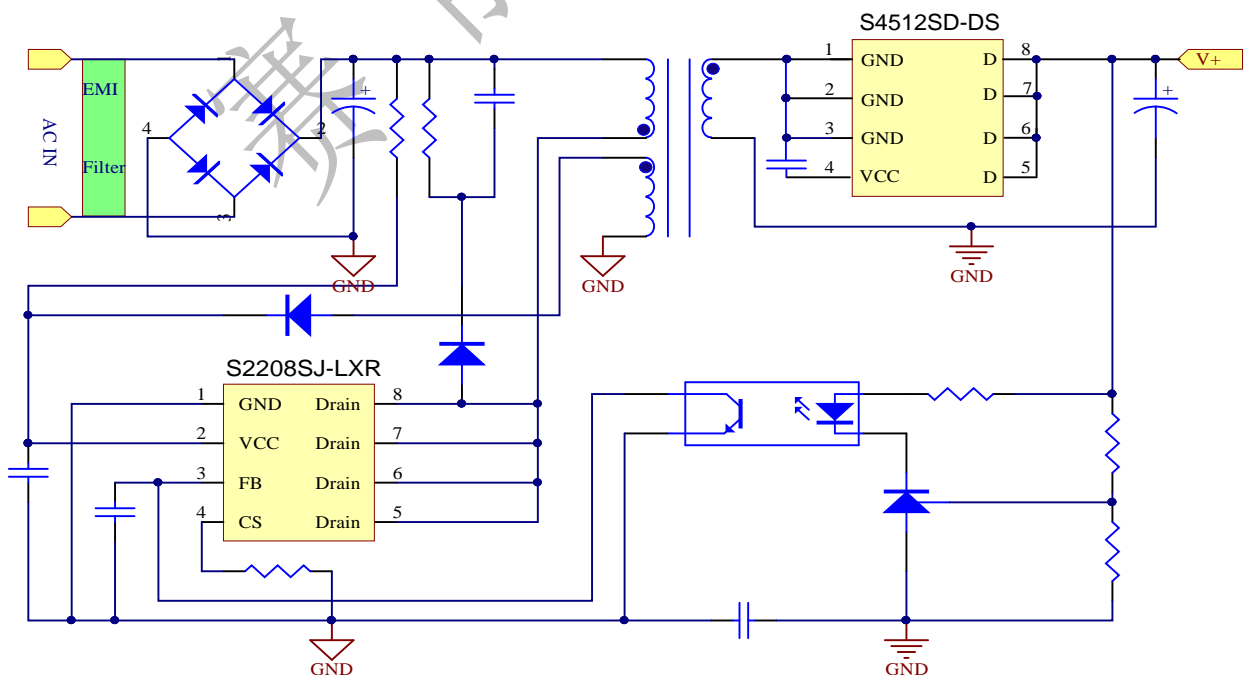
主要特点

- 固定 65K 赫兹的开关频率
- 内置抖频技术优化 EMI
- 根据负载大小自适应多种工作模式包括 打嗝模式、绿色节能模式和定频 PWM 工作模式
- 内置斜率补偿的峰值电流控制方式
- 内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
- 低空载待机功耗 ($<65\text{mW}@AC230\text{V}$) 内置前沿消隐技术
- 支持恒压输出
- 内置软启动技术
- 内置集成多种自保护功能，包括 VCC 欠压保护功能 (UVLO) VCC 过压保护功能 (OVP) 逐周期限流功能 (OCP) 过温保护功能 (OTP) CS 引脚开路保护功能 同步整流尖峰消除功能

产品应用范围

- 适配器
- QC 快充
- PD 快充

典型应用电路图



备注：Vcc 整流管用 F7 可以大幅度降低同步整流共通现象发生



输出功率信息

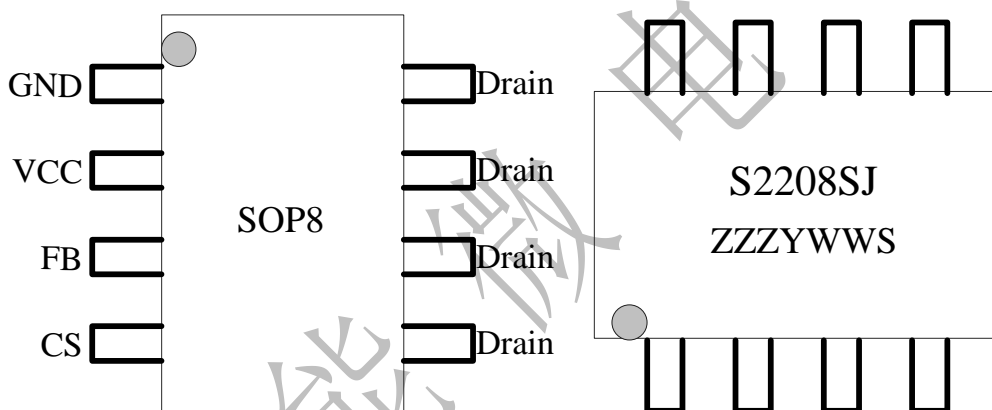
芯片名称	230V AC	90V-264V AC
S2208SJ-LXR	有现条件	有现条件
	22.5W	18W

备注：上表中的输出功率是在环境温度为 25℃ 开放式结构电源的最大推荐值，如果芯片增加散热器或者更低的环境温度则输出功率可以达到更高；

热耗散性能

描述	符号	数值	单位
芯片结到外壳热阻	$R_{\theta jc}$	19	°C/W
芯片表壳过温保护点	OTP	130	°C

封装引脚&丝印



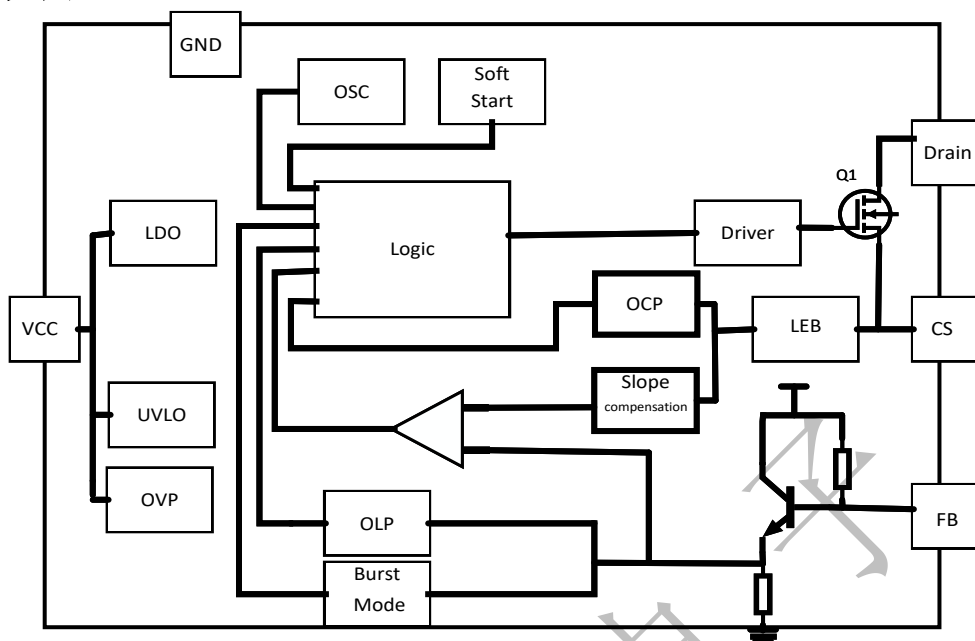
S:	SOP-8 封装
J:	内控版本号
ZZZ:	晶元批次号
Y:	生产年份 (2021 年=A, 2022 年=B, 2023=C.....)
WW:	生产周期 (01-52)
S:	加工工厂代码

订货信息

型号	封装	最小包装 (pcs)
S2208SJ-LXR	SOP-8	4000/盘
		8000/盒
		64000/箱



内部功能框图



引脚描述

引脚名称	引脚序列	功能描述
GND	Pin1	芯片内部电路电位基准引脚
VCC	Pin2	芯片内部电路供电引脚
FB	Pin3	输出反馈输脚，芯片 PWM 输出的频率和占空比由 FB 和 CS 控制
CS	Pin4	电感峰值电流采样输入引脚
PD	Pin5, 6, 7, 8	内置高压功率 MOS 的漏极

极限参数

参数说明	数值	单位
PD 对地耐压	-0.7~650	V
VCC 供电电压	-0.7~45	V
VCC 嵌位电流	10	mA
FB 对地电压	-0.7~7	V
CS 对地电压	-0.7~7	V
BIN 对地电压	-0.7~7	V
工作结温 Tj	-20~150	°C
存储温度	-40~150	°C
存储湿敏等级	MSL 3	
ESD 人体模型	2.5	KV
ESD 机械模型	250	V
焊接温度	260(≤10秒)	°C

备注：如果超过表中标注值，可能对芯片造成不可逆的永久性伤害；极限参数为最大额定值，不推荐让芯片工作在这些条件下；



推荐工作条件

参数说明	数值	单位
VCC 工作电压范围	9~40	V
外壳表面温度	-10~110	°C
PD 工作电压范围	-0.7~650	V

电气参数 (Ta=25°C, VDD=16, 除非另有说明)

符号	说明	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC						
VCC-Op	工作电压范围		9		40	V
UVLO-On	VCC 关闭电压	FB=3.0V; CS=0.4V	6.8	7.8	8.2	V
UVLO-Off	VCC 开启电压	FB=3.0V; CS=0.4V	13	13.5	16.5	V
I_VCC-ST	VCC 启动电流	VCC=12V		3	10	uA
I_VCC-Op	VCC 工作电流	VCC=16V; FB=3.0V		1.5		mA
VCC-OVP	VCC 过压保护值	FB=3.0V; CS=0.4V	41		43	V
BIN						
Vovp	关闭芯片电压阈值			2		V
FB						
VFB_Open	FB 开路电压			5.7		V
IFB_Short	FB 对地短路电流	CS=0.4V		380		uA
VTH_PL	过载电压	CS=0.4V	2	2.5		V
TD_PL	过载延迟时间	CS=0.4V		60		ms
ZFB_IN	对地电阻			30		kΩ
Max_Duty	最大占空比			75		%
CS						
TLEB	前沿消隐时间		100	400	750	ns
Zsense	对地电阻			40		kΩ
VOCP	逐周期限流值	Duty=0	0.66	0.69	0.72	V
频率						
Fosc	额定频率		60	65	70	khz
Fosc_BM	空载工作频率		17	25	28	khz
MAX_Duty	最大占空比			75		%
Δf_OSC	抖频范围			±5		%
T_shuffle	抖频周期			32		ms
HV MOSFET						
BVdss	击穿电压		650			V
Rds_on	导通电阻			1.9		Ω



功能描述

S2208SJ-LXR 是一款峰值电流控制方式的 PWM 电源管理芯片，适用于离线型的反激拓扑开关变换器。S2208SJ-LXR 内置合封一颗 $1.9\ \Omega/650\text{V}$ 的高压 MOS。芯片设计有完善的多种保护功能和自适应选择工作模式，使得适用 S2208SJ-LXR 的电源系统具有全负载高效率、低空载损耗、低 EMI 干扰和高 EMS 抗干扰、极少外围应用元件。

系统启动和静态电流

S2208SJ-LXR 的启动电流低至 $10\ \mu\text{A}$ ，启动电路的电阻值可以高达 4M ，这样使电源系统拥有更低的损耗；芯片静态电流低至 $500\ \mu\text{A}$ ，使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星 6 或者能效 6 级的能效标准。

频率抖动功能

S2208SJ-LXR 采用专用的抖频技术，在中心频率的 $\pm 5\%$ 范围内随机选择工作频率，使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的。

自适应工作模式

S2208SJ-LXR 根据 FB 脚电平自动匹配工作模式，当 FB 电平低于 1.1V 时，芯片进入打嗝工作模式，此模式下芯片工作频率为 25KHz ，最小导通时间为 $1.2\ \mu\text{s}$ ；当 FB 电平低于 1.7V 时，芯片进入变频模式，此模式下芯片工作频率在 $25\text{K}-65\text{K}$ 变动，驱动高电平时间由 FB 和 CS 电平控制；当 FB 电平大于 3.7V 时，芯片进入恒功率模式，此时芯片工作频率为 65KHz ，PWM 占空比由对应的 VOCP 控制。

内置过温保护功能

S2208SJ-LXR 检测到芯片内部达到一定温度后自动启动过温保护，过温保护时候系统处于打嗝状态，当内部温度低于设定温度值后，自动恢复电源工作。

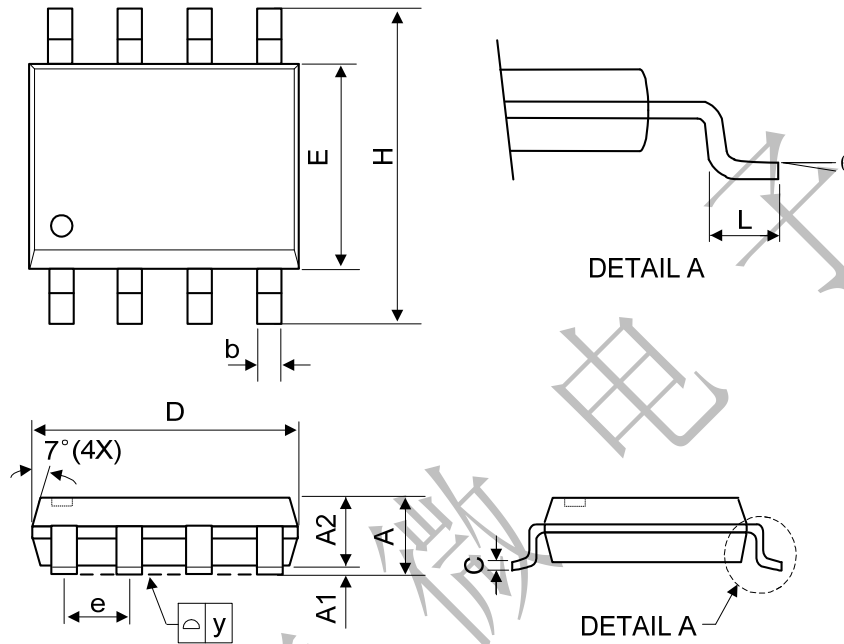
斜率补偿

S2208SJ-LXR 内置斜率补偿功能用来消除次谐波震荡。



封装外形尺寸

SOP-8



SYMBOL	MILLIMETER			INCHES		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75	-	-	0.069
A1	0.1	-	0.25	0.04	-	0.1
A2	1.25	-	-	0.049	-	-
C	0.1	0.2	0.25	0.0075	0.008	0.01
D	4.7	4.9	5.1	0.185	0.193	0.2
E	3.7	3.9	4.1	0.146	0.154	0.161
H	5.8	6	6.2	0.228	0.236	0.244
L	0.4	-	1.27	0.015	-	0.05
b	0.31	0.41	0.51	0.012	0.016	0.02
e	1.27 BSC			0.050 BSC		
y	-	-	0.1	-	-	0.004
θ	0°	-	8°	0°	-	8°